

## NOTICE DE MAINTENANCE

RECEPTEUR à TRANSISTORS portable

COFFRET Gainé plastique

COLORIS : gris clair, rouge, noir

ALIMENTATION 9 V (2 piles de 4,5 V)

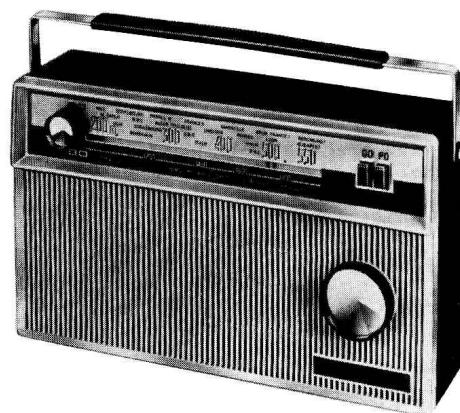
DIMENSIONS :

Largeur : 26,5 cm

Hauteur : 16,5 cm

Profondeur : 8 cm

POIDS : 1,4 kg



*Transistors* 11

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Superhétérodyne 6 transistors + 1 diode au germanium.

Sélecteur de gammes à 2 touches.

Collecteur d'ondes, antiparasite (cadre ferrite).

Contrôle automatique de volume (antifading).

Haut-parleur de 11 cm, à grand rendement.

Transformateur basse fréquence sur tôles à grains orientés.

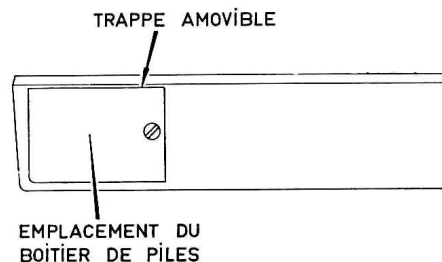
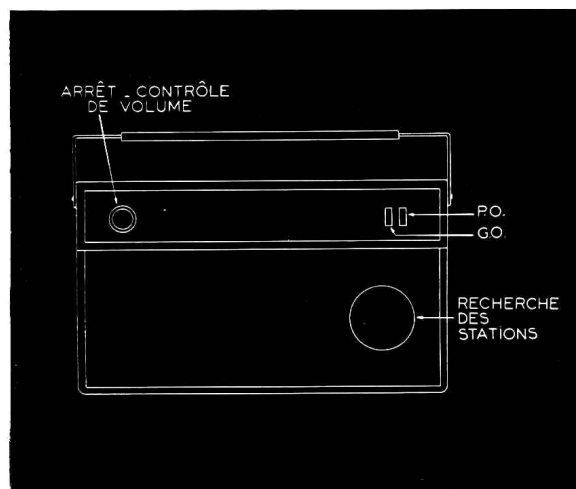
Circuits imprimés.

Cadran étalonné en noms de stations et en longueur d'ondes.

Deux gammes d'ondes :

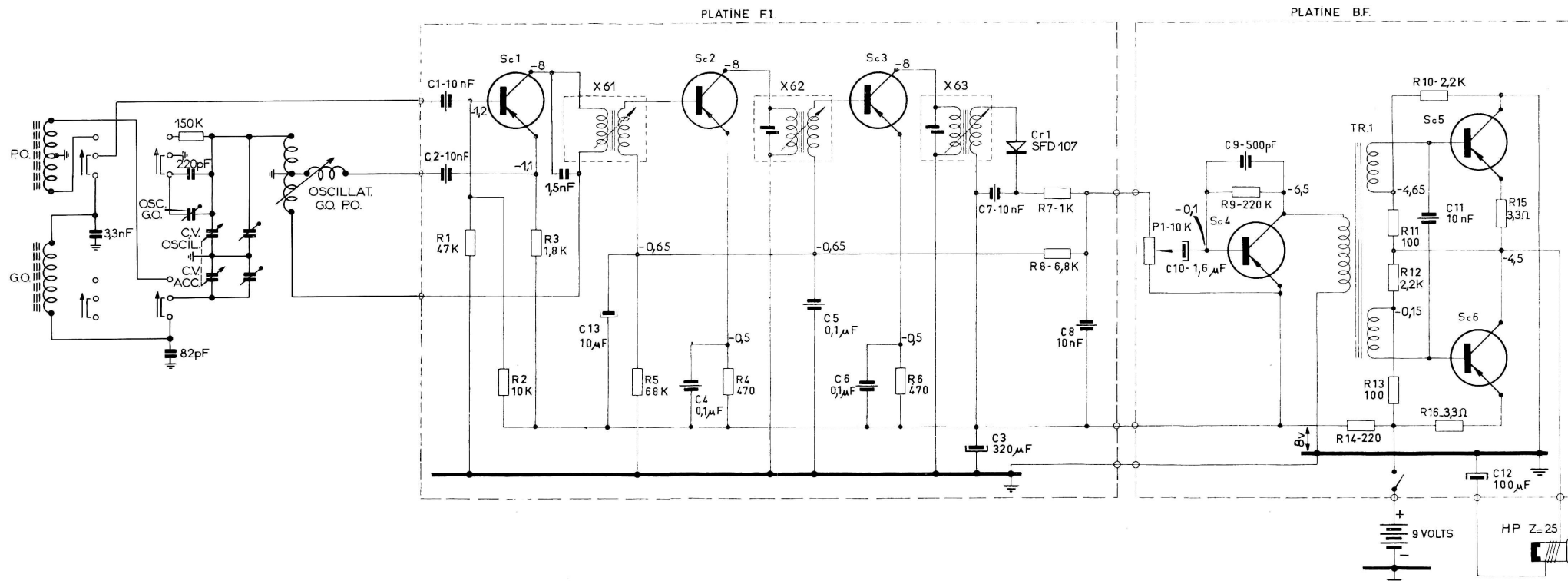
PO 185 m à 570 m.

GO 1 000 m à 1 950 m.



DOCUMENTATION CONFIDENTIELLE A L'USAGE DU DÉPOSITAIRE " ROXSTER "

**COCELAM** - Siège social : 13 - 17, Rue Perier, Montrouge (92) - Service DOCUMENTATION : 103, Bd Gabriel-Péri, Malakoff (92)



### HAUTE FREQUENCE

Le signal haute-fréquence est reçu, en PO et en GO, sur un cadre antiparasite, constitué d'un bâtonnet de ferrite portant les bobines d'accord.

Le transistor Sc 1 fonctionne en oscillateur/mélangeur.

### FREQUENCE INTERMEDIAIRE

L'amplificateur de fréquence intermédiaire utilise deux transistors du type SFT 319 (Sc 2 et Sc 3).

La liaison s'effectue par transformateurs à pots fermés, réglés sur 482 kc/s.

### DETECTION ET COMMANDE AUTOMATIQUE DE GAIN

Une diode Cr 1 (SFD 107) assure la détection. La capacité de détection C 7 est de 10 nF; le potentiomètre de volume P 1 (10 kΩ) sert de résistance de charge.

Une fraction de la tension détectée, prélevée par la résistance R 8 (6,8 kΩ), est appliquée sur la base des transistors F.I. et commande le gain de l'étage.

### DEPHASEUR

Le signal détecté attaque la base d'un transistor SFT 353, à travers un condensateur de liaison de 1,6 μF.

Un transformateur TR 1 et le transistor Sc 4 constituent l'étage déphaseur.

### ETAGE DE SORTIE BASSE FREQUENCE

L'étage de sortie basse fréquence utilise 2 transistors SFT 323 (Sc 5-Sc 6) montés en push-pull.

La bobine mobile du haut-parleur (25 Ω) sert d'impédance de charge.

Une contre-réaction de 12 dB entre collecteur et base de Sc 4 assure une large bande passante basse fréquence.

### ALIMENTATION

La tension d'alimentation est obtenue par 2 piles standard de 4,5 V en boîtier étanche, dont le négatif est relié à la masse.

Une cellule formée de R 14 (220 Ω) et C 3 (320 μF) isole l'étage push-pull du reste du récepteur, évitant ainsi les fluctuations de l'alimentation produites par les variations de courant de l'étage de sortie.

### REGLAGE

#### Alignement F.I.

482 kc/s { Injecter le signal sur la base du transistor Sc 1.  
Chercher le maximum de tension détectée à l'aide des transformateurs X 61 - X 62 - X 63.

#### Alignement H.F.

##### P.O.

Oscillateurs { 520 kc/s (CV fermé) régler la bobine oscillatrice PO/GO.  
1 610 kc/s (CV ouvert) régler le trimmer oscillateur du CV.

##### Accord

574 kc/s (CV fermé) agir sur la bobine PO - cadre.

1 400 kc/s (CV ouvert) agir sur le trimmer accord du CV.

##### G.O.

Oscillateur { 282 kc/s (CV ouvert) régler le trimmer oscillateur GO.

Accord { 173 kc/s (CV fermé) agir sur la bobine GO du cadre.

